خطی سازی تقویت کننده های توان بالا با استفاده از روش Feed Forward اصلاح شده

محمدرضا متولى كسمائي و كلاوس سولباخ

چکیده: این مقاله یک مدار اصلاح شده برای بهبود خطی سازی تقویت کننده های توان بالا بر اساس مدل مدار تقویت کننده فیدفوروارد ارائه می دهد. به کمک مدل ریاضی المان های مورد استفاده، مدار اصلاح شده شبیه سازی، ساخته و اندازه گیری شده است. مدل تقویت کننده توان بالا، به وسیله تقریب دامنه تابع تبدیل و فاز بهره تقویت کننده (که به دامنه ورودی وابسته است) با استفاده از سری تیلور مختلط که فرم ساده شده سری ولترا ماست، انجام گرفت. در اثبات کار کرد عملی طرح، متوجه شده ایم که تنظیمات مدار به شرایط هدایت تقویت کننده ها بستگی دارد و خطی شدن سیگنال ها فقط برای یک محدوده باریکی از توان ورودی (یا دامنه ورودی) قابل دسترسی است. تبدیل دو تقویت کننده توان بالا تعیین شده است. مدار جدید در مقایسه با تقیمت اعظم شبیه سازی کل مدار به وسیله مدل ناشی از مشخصه های تابع تبدیل دو تقویت کننده توان بالا تعیین شده است. مدار جدید در مقایسه با تعیان مدار های مزاحم نوع TMD را نیز در دامنه های ورودی بزرگ (سیگنال های سیگنال های مزاحم نوع TMD را نیز در دامنه های ورودی بزرگ (سیگنال های

کلیدواژه: تقویتکننده توان بالا، تقویتکننده فیدفوروارد، سری ولترا، سیگنالهای نوع ۳IMD.

۱ – مقدمه

استفاده از تقویت کننده های توان بالای RF با قابلیت خطی بالا برای سیستمهای ارتباطات موبایل و ماهواره ای امری ضروریست. به عنوان مثال در سیستمهای موبایل نسل دوم 'GSM و سوم 'GPP تعداد زیادی سیگنال با فرکانسهای متفاوت به طور همزمان از تقویت کننده های توان بالا در ایستگاه های زمینی 'BS ارسال می شوند [۱]. برای جلوگیری از کاملاً خطی باشد و خطی کردن آنها به روش کلاسیک امکان ندارد. دامنه سیگنال های مزاحم در خروجی تقویت کننده ها به بزرگی دامنه سیگنال های مزاحم در خروجی تقویت کننده ها به بزرگی دامنه سیگنال های ورودی بستگی دارد و از این رو سیگنال های ورودی با بین سیگنال های خروجی و ورودی یک تقویت کننده را در قالب یک تابع بین سیگنال های خروجی و ورودی یک تقویت کننده را در قالب یک تابع بسط داده شده باشد، مشاهده می کنیم که برای دامنه های بزرگتر، نقش

این مقاله در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۳ دریافت و در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۴ بازنگری شد.

محمدرضا متولی کسمائی، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم (email: motavallireza@gmail.com).

کلاوس سولباخ، گروه مخابرات- فرکانس های بالا، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه دیسبورگ، دیسبورگ، آلمان، (email: hft@uni-due.de).

1. Global System Mobile

2. Generation Partnership Project

3. Base Station



شکل ۱: مشخصه خروجی به ورودی تقویتکننده توان بالا، (الف) تابع تبدیل توان و (ب) تابع تبدیل فاز ولتاژ.

عبارتهای درجات بالاتر، بیشتر و مهمتر می شود یعنی رفتار تقویت کننده دیگر خطی نیست و تقویت کننده رفتار غیرخطی دارد. این موضوع می تواند به وضوح در مشخصه های توابع تبدیل AM/AM و AM/PM و AM/PM در شکل ۱ دیده شود. محدوده اشباع به لحاظ توان خروجی بالا و در نتیجه بازدهی بالای آن در سیستمهای ارتباطات موبایل و ماهواره ای نقش مهمی را بازی می کند و سیگنالهای مزاحم با دامنه های بزرگ در این محدوده از تقویت کننده تولید شده که منجر به تغییر شکلهای بزرگ در خروجی می شوند. به طور کلی عامل غیر خطی برای یک تقویت کننده می تواند در دو فرم مختلف ظاهر شود، تولید مؤلفه فرکانسهای جدید در خروجی تقویت کننده یا وابستگی دامنه و فاز بهره تقویت کننده به دامنه سیگنال یا سیگنالهای ورودی و به عبارت دیگر انحراف بهره تقویت کننده برای دامنههای بزرگ (شکلهای ۲– ب و - ب).



شکل ۳: اندازه گیری های تابع تبدیل تقویت کننده B بر حسب توان ورودی، (الف) سیگنال های اصلی و IMD درجات مختلف و (ب) قدر مطلق و فاز بهره ولتاژ.

شکل ۱- الف) عمل می کند. هنگامی که پوش سیگنالهای ورودی ثابت نباشد و بین یک مقدار بیشینه و کمینه تغییر کند کار دشوار می شود (به عنوان مثال برای حالت سیگنال ورودی با بیش از یک فرکانس) و از آنجایی که حداکثر توان پوش کل سیگنالهای ورودی برابر با جمع توان متوسط تکتک سیگنالها است، تقویتکننده با یک دامنه بزرگ در ورودی خود مواجه است و از کل مشخصه تابع تبدیل خود (محدوده خطی و غیر خطی در شکل ۱-الف) بهره میجوید. ارتفاع توان پوش سیگنالهای ورودی با بزرگی دامنه سیگنالها و تعداد آنها نسبت مستقیم دارد. معمولاً تقویت کنندهها طوری هدایت می شوند که حداکثر ارتفاع توان پوش سیگنالهای ورودی، برابر یا کمتر از dB compression point پوش تقویت کننده باشد. وقتی توان پوش سیگنالهای ورودی بیشتر از این توان باشد، أن گاه تغييرات غير خطى در خروجى تقويت كننده به فرم سیگنالهای نوع TIMD یا سیگنالهای مزاحم نوعهای دیگر ظاهر می شود. یکی از روش های خطی کردن تقویت کننده های توان بالا، مدار تقویت کننده فیدفوروارد است که در سیستمهای ارتباطات موبایل در ایستگاههای زمینی به وفور استفاده می شود [۳] تا [۶]. این روش نسبت به مدارهای دیگر انعطاف پذیرتر است و قبل از هر چیز برای سیگنالهای با یهنای باند زیاد مناسب است اما برای سیگنالهای بزرگ (دامنههای



desired signal

شکل ۲: اندازه گیری های تابع تبدیل تقویت کننده A بر حسب توان ورودی، (الف) سیگنال های اصلی و IMD درجات مختلف و (ب) قدر مطلق و فاز بهره ولتاژ.

هنگامی که فرکانس سیگنالهای ورودی یک تقویت کننده متعدد باشد، نوعی از سیگنالهای مزاحم تولیدشده یعنی سیگنالهای 'TIMD باید بیش از دیگر سیگنالهای مزاحم در خروجی مورد توجه قرار گیرند چرا که به فرکانس سیگنالهای اصلی بسیار نزدیک هستند. آنها در محدوده پهنای باند مفید تقویت کنندهها قرار دارند و به علت محدودیت ساخت فیلترها در عمل قابل حذف نمیباشند [۲]. در ایستگاهای زمینی، سیگنالهای TIMD به وسیله تقویت کنندههای توان بالا در کل باند ارسالی منتشر میشوند و باعث ایجاد مزاحمت و تداخل^۲ در باند کانال خودی و نیز کانالهای همسایه می گردند. این مشکل حتی در شبکههای تلویزیونی نیز اتفاق میافتد (به وسیله سیگنالهای TIMD و حتی سیگنالهای TIMD)، جایی که تعداد زیادی کانال در یک فاصله فرکانسی نزدیک به هم قرار می گیرند.

تقویت سیگنالهای ورودی با پوش⁷ ثابت مشکل ساز نیست (به عنوان مثال برای حالت سیگنال ورودی با یک فرکانس). از آنجایی که حداکثر توان پوش سیگنال ورودی برابر با توان متوسط سیگنال است، تقویت کننده با یک نقطه ثابت در مشخصه تابع تبدیل (محدوده خطی در

-1 dB:

^{1.} Third Order Intermodulation Distortion

^{2.} Interference

^{3.} Envelope



شكل ۴: مدار نقويت كننده فيدفوروارد متداول.

بزرگ در محدوده اشباع) مناسب نیست و به عبارت دیگر حذف سیگنالهای نوع ۳IMD به وسیله این روش در توانهای خروجی بالا انجام نمی گیرد. همچنین قابلیت خطی بالای این تکنیک با از دست دادن مقدار قابل ملاحظه بازدهی آن میسر است که تقریباً در عمل بین ۷٪ تا ۱۱٪ است [۷] و [۸]. در ارتباط با نقاط ضعف اشارهشده برای مدار فيدفوروارد متداول، سؤال اين است كه آيا ممكن است سيگنالهاي مزاحم نوع TIMD در توانهای خروجی بالا هم به مقدار قابل توجه حذف شوند و حتی برای یک دامنه ورودی مشخص (یا برای یک محدوده ورودی مشخص) صفر شوند و نیز آیا امکان افزایش بازدهی مدار وجود دارد؟ از این جهت سعی شده که ابعاد مدار فیدفوروارد متداول را طوری تغییر دهیم که خواستههای بالا برآورده و نیز حذف سیگنالهای نوع ۳IMD برای سیگنالهای کوچک و همزمان سیگنالهای بزرگ را ممکن کنیم. در ارتباط با پایین بودن بازدهی مدار فیدفوروارد متداول باید گفت که اولاً این مسئله به کارکرد تقویتکننده اصلی (تقویتکننده A) که یک تقویت کننده کلاس A است، برمی گردد (شکل ۴). همچنین تقویت کننده کمکی (تقویت کننده B) نیز کاملاً خطی است به طوری که که خود سیگنالهای مزاحم نوع ۳IMD را تولید نمی کند و فقط سیگنالهای ۳IMD تولیدشده توسط تقویت کننده اصلی را تقویت می کند. به عبارت دیگر تقویت کننده کمکی با وجود مصرف توان مستقیم DC برای تقویت سیگنالهای اصلی ورودی به کار نمیرود. از آنجایی که تقویت کننده کمکی به طور ضعیف هدایت می شود (دامنه سیگنال های ورودی کوچک است) و نیز به علت کارکرد تقویت کننده اصلی، یک نسبت خوب حذف سیگنالهای نوع ۳IMD برای دامنههای کوچک به دست میآید و به عبارت دیگر حذف سیگنالهای نوع ۳IMD برای دامنههای بزرگ به شدت کم می شود. در طرح جدید تقویت کننده کمکی علاوه بر تقویت سیگنالهای TIMD، سیگنالهای اصلی را نیز تقویت میکند که بدین وسيله بازدهي مدار افزايش مي يابد (شكل ۵). علاوه بر اين هر دو تقویت کننده اصلی و کمکی $(A \ e \ B)$ کاملاً مشابه و دارای بهره یکسان میباشند که بدین ترتیب جمع توان های سیگنال های اصلی در (V)خروجی مدار ظاهر میشود. طرح جدید از یک طرف، توان خروجی (توان سیگنالهای اصلی) دو تقویت کننده یکسان را ترکیب و از طرف دیگر سیگنالهای خروجی را به طور قابل ملاحظهای خطی میکند. مطابق شکل ۵ سیگنال ولتاژ ورودی S_{in} بعد از تقسیم شدن به تقویت کنندهها تزريق مى شود با اين تفاوت كه خروجى تقويت كننده A به وسيله دو تزویج کننده مشابه با ثابتهای تزویج jk (j نمایانگر تغییر فاز °۹۰ می باشد) در تغذیه تقویت کننده B نقش ایفا می کند (فرض می شود که سیگنالهای مزاحم تولیدشده توسط دو تقویت کننده در حالت ایده آل یکسان و برابر با S' باشد(. در مرحله بعدی سعی می شود که عبارت





شکل ۵: مدار جمع کننده خطی با مقادیر مشخص شده سیگنال ها در آن.

 VK^{r} (در ورودی تقویت کننده B) برابر با ۲ انتخاب شود تا سیگنالهای اصلی ورودی دو تقویت کننده یکسان باشد (از آنجایی که دامنه سیگنال مراحم r'S' در ورودی تقویت کننده B بسیار کوچک تر از سیگنال مزاحم تولیدشده توسط تقویت کننده B تقریباً اصلی S است، سیگنال مزاحم تولیدشده توسط تقویت کننده A است). با مقایسه برابر با سیگنال مزاحه بالایی و پایینی، ضمن حذف سیگنال های مزاحم به وسیله جمع کننده، ۲ برابر توان ورودی در خروجی حاصل می شود.

۲- مدل ریاضی

برای تشکیل مدل ریاضی تقویت کنندههای توان بالا از اندازه گیریهای مشخصه توابع تبدیل توان استفاده شده است. به عبارت دیگر رفتار هر تقویت کننده در ارتباط با dB compression point و سیگنالهای نوع VIMD ، ۵IMD ، ۳IMD و ۹IMD جداگانه اندازه گیری می شود. حال برای توصيف رياضي اين رفتار، ولتاژ خروجی تقويت کننده نسبت به ولتاژ ورودی در یک سری بسط داده می شود. در ابتدا از سری تیلور برای این توصيف استفاده شد كه به دليل غير خطى بودن شديد، مدل به دست آمده متناسب با رفتارهای حقیقی تقویت کنندهها نبوده است (پیوست را ببینید). در مرحله بعد از سری ولترا که نسبت به سریهای دیگر انعطافپذیرتر و برای توصیف سیستمهای غیر خطی مناسبتر است، استفاده شد [۹] تا [۱۱]. اندازه گیری های مشخصه توابع تبدیل توان با دو سیگنال اصلی ً و با توان های یکسان به عبارتی با دامنه های ولتاژ برابر انجام گرفته است. تفاوت اندازهگیریها با دو سیگنال اصلی در مقایسه با یک سیگنال اصلی^{^۵} در این است که برای حالت دو سیگنال اصلی، فرکانسهای ۳IMD در خروجی تقویت کنندهها در یک باند فرکانسی باریک تولید می شود (فرکانسهای درجات مختلف IMD و نوع TIMD برای یک سیگنال اصلی ایجاد نمی شود). در محاسبات انجامشده، اثبات گردیده که اگر هر دو دامنه ولتاژ سیگنالهای ورودی برابر باشند (همچون حالت متداول در GSM) سری ولترا به سری تیلور با ثابتهای مختلط تبدیل می شود [۱۲]. حال برای درست کردن مدل یک تقویت کننده با ثابتهای مختلط باید اندازه گیری های مختلط هم در دسترس باشد، لذا از اندازه گیری های بهره تقويت كننده ($\underline{v} = \underline{S}_{r_1}$) در محدوده اشباع نيز استفاده شده است. براى تشکیل مدل ریاضی، دو سیگنال ولتاژ سینوسی با دامنههای ورودی برابر و فرکانسهای $f_{\chi}(\omega_{\chi})$ و $f_{\chi}(\omega_{\chi})$ در سری تیلور بسط داده \hat{u}_{in} می شود. سیگنال های تولیدشده شامل فرکانس های اصلی ورودی و تمام فرکانسهای جدید تولیدشده در خروجی تقویت کننده را می توان در قالب

۳. k=۰٫۱ (تزویج کنندههای جهتدار dB ۲۰- هستند.)

^{3.} Volterra Series

^{4.} Two Tone

^{5.} One Tone

یک فرم کلی به صورت (۱) خلاصه کرد [۱۲] و در آن N حداکثر درجه سری تیلور، n اندیس متغیر، m درجه سیگنالهای IMD تولیدشده (عدد صحیح) است که سهم (عدد صحیح) است که سهم سیگنالهای اصلی (یا فرکانسهای اصلی) و سیگنالهای IMD درجات مختلف (π تا ۹) به صورت زیر است

$$\hat{u}_{out,F} = \sum_{n=1}^{\frac{N-1}{\gamma}} {\binom{\gamma n+1}{n}} {\binom{\gamma n+1}{n}} \frac{\hat{u}_{in}^{\gamma n+1}}{r^{\gamma n}} c_{\gamma n+1}$$
(Y)

$$\hat{u}_{out,\tau IMD} = \sum_{n=1}^{\frac{N-1}{r}} {\binom{\tau n+1}{n}} {\binom{\tau n+1}{n-1}} \frac{\hat{u}_{in}^{\tau n+1}}{\tau^{\tau n}} c_{\tau n+1}$$
(Y)

$$\hat{u}_{out,\diamond IMD} = \frac{\sum_{n=\tau}^{N-1} {\tau \choose n} {\tau n+1 \choose n-\tau} \frac{\hat{u}_{in}^{\tau n+1}}{\tau^{\tau n}} c_{\tau n+1} \qquad (\mathfrak{F})$$

$$\hat{u}_{out,\text{vIMD}} = \sum_{n=\tau}^{\frac{N-1}{\tau}} {\binom{\tau n+1}{n}} {\binom{\tau n+1}{n-\tau}} \frac{\hat{u}_{in}^{\tau n+1}}{\tau^{\tau n}} c_{\tau n+1} \qquad (\Delta)$$

$$\hat{u}_{out,\text{MDD}} = \sum_{n=\tau}^{\frac{N-1}{\gamma}} {\binom{\gamma n+1}{n}} {\binom{\gamma n+1}{n-\tau}} \frac{\hat{u}_{in}^{\gamma n+1}}{\tau^{\gamma n}} c_{\gamma n+1}$$
(\$

همان گونه که در (۲) تا (۶) می بینیم، فقط ثابتهای فرد (c_{rn+1}) در سری ظاهر شدهاند چرا که فقط این ثابتها در تعیین سیگنالهای IMD مورد نظر (AIMD، شاک و در پهنای باند (میان گذر) ما قرار دارند) (سیگنالهای با ثابتهای زوج در خارج از این پهنای باند قرار دارند). علاوه بر این، دامنه سیگنالهای IMD درجات زوج (TimD، شاک باند فرد علاوه بر این، دامنه سیگنالهای IMD درجات زوج (TimD، شاک باند فرد است (شکل 1– الف).

لازم به ذکر است که مدل ریاضی تقویت کنندههای توان بالا وقتی دقیقتر می شود که سیگنالهای IMD درجات مختلف بیشتری را بر حسب توان ورودی توصیف کنیم و نیز وقتی که ثابتهای بیشتری را در سری انتخاب کنیم. اما باید توجه کرد که با افزایش دامنه سیگنالهای ورودی، دقت ثابتهای درجات بزرگتر نسبت به درجات کوچکتر کمتر می شود که این خود منجر به تشکیل یک مدل با دقت کمتر می گردد. با مشخص شدن ثابتهای سری می توان چندجمله ای های به دست آمده را به عنوان مدل ریاضی تقویت کننده معرفی کرد.

در شکلهای ۲ و ۳ نتایج اندازه گیریها برای سیگنالهای اصلی و سیگنالهای IMD درجات مختلف (برای حالت two tone) و مقادیر قدر مطلق و فاز بهره ولتاژ (برای حالت one tone) دو تقویت کننده بر حسب توان ورودی نشان داده شده است. همان گونه در شکلهای ۲ و ۳ میبینیم با وجود این که هر دو تقویت کننده کاملاً یکسان هستند، منحنیهای متناسب آنها یکی نیست. از طرف دیگر اختلاف اندازه سیگنالهای IMD درجات یکسان (دو سیگنال IMD قرارگرفته در دو طرف سیگنالهای اصلی) هر تقویت کننده علیالخصوص برای دامنههای بزرگ قابل رؤیت است (علی رغم یکسان بودن آنها در تئوری). برای تجزیه و تحلیل این اختلاف، ترانزیستورهای غیر خطی تشکیل دهنده

(١)

تقویت کننده توان بالا نقش مهمی را بازی می کنند. سیگنالهای مزاحم تولیدشده توسط اولین ترانزیستور به وسیله عبور از ترانزیستور بعدی و ترانزیستورهای بعدی چندین بار تقویت می شوند و بدین وسیله سیگنالهای نوعهای مختلف نغییر ماهیت می دهند یعنی این که سیگنالهای نوعهای دیگر) به سیگنالهای MDL درجات بالاتر (و میگنالهای نوعهای دیگر) به سیگنالهای MDL درجات پایین ر از جمله سیگنالهای نوعهای دیگر) به سیگنالهای حقیقی تغییر فازهای قابل مزاحم درجات بالاتر در تقویت کنندههای حقیقی تغییر فازهای قابل محسوس را تجربه می کنند به طوری که سیگنالهای تولیدشده MDL درجات پایین تر، انحراف فازی بزرگی را نسبت به سیگنالهای تولیدشده که باید با آنها جمع شوند، نشان می دهند. به عبارت دیگر تبدیلهای مطرام MA/AM و MM/PM (شکل ۱) که به طور متوالی و پشت سر هم اتفاق می افتند در این اختلاف نقش دارند [۱۲].

حال برای مشخص کردن ثابتهای سری، معادلات سیستم سیگنالهای مطرحشده به کمک مقادیر اندازه گیری نوشته می شود. $M_{,}$ معادلات سیستم برای سیگنالهای اصلی (معادله (۲)) که از تعداد $M_{,}$ معادلات اسیستم برای سیگنالهای اصلی (معادله (۲)) که از تعداد به مقادیر اندازه گیری متناظر \hat{U}_{in} و \hat{U}_{out} تشکیل می گردد، می تواند به صورت زیر خلاصه شود (از آنجایی که مقادیر اندازه گیری ها در سمت چپ (۲) حقیقی هست از قدر مطلق عبارات سمت راست استفاده می شود)

$$\begin{pmatrix} \hat{u}_{out,F,\gamma} \\ \hat{u}_{out,F,\gamma} \\ \vdots \\ \hat{u}_{out,F,M_{\gamma}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{u}_{in,\gamma} & \frac{q}{r} \hat{u}_{in,\gamma}^{\tau} & \cdots & \begin{pmatrix} N \\ \frac{N-\gamma}{r} \end{pmatrix}^{r} \frac{\hat{u}_{in,\gamma}^{N}}{r^{N-\gamma}} \\ \hat{u}_{in,\gamma} & \frac{q}{r} \hat{u}_{in,\gamma}^{\tau} & \cdots & \begin{pmatrix} N \\ \frac{N-\gamma}{r} \end{pmatrix}^{r} \frac{\hat{u}_{in,\gamma}^{N}}{r^{N-\gamma}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \hat{u}_{in,M_{\gamma}} & \frac{q}{r} \hat{u}_{in,M_{\gamma}}^{\tau} & \cdots & \begin{pmatrix} N \\ \frac{N-\gamma}{r} \end{pmatrix}^{r} \frac{\hat{u}_{in,\gamma}^{N}}{r^{N-\gamma}} \\ \vdots \\ c_{N}e^{j\varphi_{c_{N}}} \\ \vdots \\ c_{N}e^{j\varphi_{c_{N}}} \end{pmatrix}$$
 (Y)

معادلات سیستم برای سیگنالهای نوع ۳IMD نیز مشابه معادلات سیگنالهای اصلی و بر اساس (۳) برای M_{τ} مقادیر اندازه گیری می تواند به صورت (۸) خلاصه گردد که معادلات سیستم سیگنالهای IMD درجات بالاتر نیز به طریق مشابه به دست می آیند.

برای نوشتن معادلات سیستم مربوط به بهره تقویت کننده، سیگنال ولتاژ خروجی بر حسب ولتاژ ورودی با دامنه \hat{u}_{in} و فرکانس $f_{\gamma}(\alpha_{\gamma})$ در سری تیلور بسط داده می شود. عبارت ولتاژ خروجی برای فرکانس اصلی را می توان به صورت (۹) خلاصه کرد

$$u_{out}(t) = \sum_{m=\cdot}^{N-1} \left\{ \sum_{n=m}^{N-1} {\binom{\gamma n+1}{n}} \binom{\gamma n+1}{n} \binom{\gamma n+1}{n-m} \frac{\hat{u}_{in}^{\gamma n+1}}{\boldsymbol{r}^{\gamma n}} c_{\gamma n+1} \cos(((m+1)\omega_{\gamma} - m\omega_{\gamma})t)) \right\} + \frac{\sum_{m=\cdot}^{N-1}}{\sum_{n=m}^{\gamma}} \left(t \right) \left\{ \sum_{n=m}^{N-1} {\binom{\gamma n+1}{n}} \binom{\gamma n+1}{n-m} \frac{\hat{u}_{in}^{\gamma n+1}}{\boldsymbol{r}^{\gamma n}} c_{\gamma n+1} \cos(((m+1)\omega_{\gamma} - m\omega_{\gamma})t)) \right\}$$

$$\hat{u}_{out,G} = c_{\nu}\hat{u}_{in} + \frac{r}{r}c_{\nu}\hat{u}_{in}^{\tau} + \frac{\gamma}{\gamma\varsigma}c_{\rho}\hat{u}_{in}^{\rho} + \ldots + \left(\frac{N}{\frac{N-\gamma}{r}}\right)\frac{\hat{u}_{in}^{N}}{r^{N-\gamma}} \quad (9)$$

در انتقال به ثابتهای مختلط C_N (۹) میتواند در سری تیلور مختلط به صورت زیر نوشته شود

$$\underline{\underline{U}}_{out,F} = \underline{\underline{C}}_{\nu}\hat{\underline{u}}_{in} + \frac{\underline{\mathbf{r}}}{\underline{\mathbf{r}}}\underline{\underline{C}}_{\nu}\hat{\underline{u}}_{in}^{\tau} + \frac{\underline{\mathbf{v}}}{\underline{\mathbf{v}}}\underline{\underline{C}}_{\delta}\hat{\underline{u}}_{in}^{\delta} + \dots + \left(\frac{N}{\underline{N-\mathbf{v}}}\right)\frac{\hat{\underline{u}}_{in}^{N}}{\underline{\mathbf{r}}^{N-\underline{\mathbf{v}}}}\underline{\underline{C}}_{N} \quad (\mathbf{v}\cdot)$$

یا برای بهره مختلط $v = v_{rv}$ داریم

$$\underline{v} = \frac{\underline{U}_{out,F}}{\hat{u}_{in}} = \underbrace{\underline{C}_{i}}_{in} + \underbrace{\underline{v}}_{\underline{v}} \underline{C}_{s} \hat{u}_{in}^{\underline{v}} + \ldots + \underbrace{\binom{N}{N-1}}_{\underline{v}} \underbrace{\underline{u}_{in}^{N-1}}_{\underline{v}} \underline{C}_{N} \tag{11}$$

معادلات سیستم بهره تقویت کننده برای $M_{_{f}}$ مقادیر اندازه گیری عبارت است از

$$\begin{pmatrix} \underline{v} \\ \underline{v} \\ \vdots \\ \underline{v}_{M_{r}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v & \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}} \hat{u}_{in,v}^{\mathsf{r}} & \cdots & \begin{pmatrix} N \\ \underline{N-v} \\ \frac{N-v}{\mathbf{v}} \end{pmatrix} \frac{\hat{u}_{in,v}^{N-v}}{\mathbf{v}^{N-v}} \\ v & \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}} \hat{u}_{in,v}^{\mathsf{r}} & \cdots & \begin{pmatrix} N \\ \underline{N-v} \\ \frac{N-v}{\mathbf{v}} \end{pmatrix} \frac{\hat{u}_{in,v}^{N-v}}{\mathbf{v}^{N-v}} \begin{pmatrix} \underline{C}_{v} \\ \underline{C}_{\mathbf{v}} \\ \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ v & \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}} \hat{u}_{in,M_{k}}^{\mathsf{r}} & \cdots & \begin{pmatrix} N \\ \underline{N-v} \\ \frac{N-v}{\mathbf{v}} \end{pmatrix} \frac{\hat{u}_{in,M_{k}}^{N-v}}{\mathbf{v}^{N-v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{C}_{v} \\ \underline{C}_{v} \\ \vdots \\ \underline{C}_{N} \end{pmatrix}$$
(17)

 $\varphi_{\underline{S}_n} = \angle \underline{v}$ ، ($|\underline{S}_n| = |\underline{v}|$)، حال باید قدر مطلق و و فاز بهره تقویت کننده با $|\underline{S}_n| = |\underline{v}|$ ، با طور جداگانه به عنوان مقادیر حقیقی در نظر گرفته شود.

از آنجایی که ثابتهای سری تیلور باید در همه معادلات سیستم صدق کنند و به عبارت دیگر چون همه معادلات سیستم باید همزمان حل شوند، میتوانیم همه معادلات سیستم به دست آمده را در یک معادلات سیستم بزرگ خلاصه کنیم (رابطه (۱۳)). توجه شود که سری تیلور تا درجه ۱۳ انتخاب شده است و بدین ترتیب معادلات سیستم خطی حاصل میشود که به تعداد مقادیر اندازه گیری ها ($M_{1}, M_{2}, M_{3}, M_{4}, M_{5}$) را ستگی دارد. توجه شود که و نیز به درجه انتخاب شده سری تیلور (N) بستگی دارد. توجه شود که تعداد مقادیر اندازه گیری ها یکسان نیست و بر حسب طول قابل

۳- بهینهسازی

در این قسمت سعی میشود که مشخصه توابع تبدیل توان و بهره تقویت کننده به صورت یک مدل در قالب مسئله تقریب ریاضی آورده شود، به عبارت دیگر مدلی جستجو میشود که به رفتار اندازه گیریهای عملی تا حد امکان نزدیک باشد. برای این کار از روش بهینه سازی به طریق عددی استفاده میشود به این معنی که به کمک مشخص کردن ثابتهای مدل، اختلاف بین مدل و اندازه گیریها را کمینه می کنیم. برای بهینه سازی از روش حداقل مربعات (Least Square Method) استفاده میشود که ثابتهای مدل را از طریق صفر کردن مشتقات جزیی مشخص می کند [۱۴] یعنی

$$e = \sum_{i=1}^{n} g_i (|y_m(\underline{C})| - y_i)^{\mathsf{r}}$$
(14)

و برای رابطه فازی

$$e = \sum_{i=1}^{n} g_i (\angle y_m(\underline{C}) - \varphi_i)^{\mathsf{r}}$$
(1)

که p تابع خطا، y_i مقادیر خروجی اندازه گیری شده، y_m مقادیر خروجی مدل، e تابع وزنی، مدل، ϕ_i مقادیر خروجی اندازه گیری شده برای فاز بهره، g_i تابع وزنی، n تعداد مقادیر اندازه گیریها است. معادل (۱۴) و (۱۵) برای حالت برداری (Euclidean Norm) برابر است با

$$\min(g_i | y_m(\underline{C}) | - y_{ix}) \tag{18}$$

که در حالت ماتریسی به رابطه زیر تبدیل می شود

$$\min \left(g_{i} \left| \begin{pmatrix} y_{y,y} & y_{y,y} & \cdots & y_{y,y} \\ y_{y,y} & y_{y,y} & \cdots & y_{y,y} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{M,y} & y_{M,y} & \cdots & y_{M,y} \end{pmatrix} \left(\frac{\underline{C}}{z}_{y} \\ \vdots \\ \underline{C}_{yy} \\ \end{bmatrix} - \left(\frac{y_{y}}{z} \\ y_{M} \\ \right)_{y} \right) \right) (YY)$$
$$= \min(g_{i} |A\underline{C}| - b_{y})$$

که در آن A ماتریس اصلی و b بردار خروجی متناسب است. طبیعی است که برای معادلات سیستم بزرگ (رابطه (۱۳)) باید همه سیگنالهای خروجی مورد بحث ملاحظه شوند. به این دلیل تابع ارزش (Cost) (Tost) به عنوان تابع خطای کل، که جمع جداگانه همه تابعها (توابع خطا) را شامل می شود تشکیل می گردد. برای ۶ سیگنال خروجی (۱۸) را داریم

$$\begin{pmatrix} \hat{u}_{out,\tau IMD,\gamma} \\ \hat{u}_{out,\tau IMD,N_{\tau}} \\ \vdots \\ \hat{u}_{out,\tau IMD,M_{\tau}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{r}{r} \hat{u}_{in,\gamma}^{\tau} & \frac{\delta}{\gamma_{\mathcal{F}}} \hat{u}_{in,\gamma}^{\delta} & \cdots & \begin{pmatrix} N \\ \frac{N-\gamma}{r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N \\ \frac{N-\gamma}{r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{n}{r} \hat{u}_{in,\gamma}^{\tau} \\ \frac{\delta}{r} \hat{u}_{in,\gamma}^{\delta} & \frac{\delta}{\gamma_{\mathcal{F}}} \hat{u}_{in,\gamma}^{\delta} & \cdots & \begin{pmatrix} N \\ \frac{N-\gamma}{r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N \\ \frac{N-\gamma}{r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{n}{r} \hat{u}_{in,\gamma}^{T} \\ \frac{r}{r} \hat{u}_{in,M_{\tau}}^{\tau} & \frac{\delta}{\gamma_{\mathcal{F}}} \hat{u}_{in,M_{\tau}}^{\delta} & \cdots & \begin{pmatrix} N \\ \frac{N-\gamma}{r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N \\ \frac{N-\gamma}{r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{n}{r} \hat{u}_{in,M_{\tau}}^{T} \\ \frac{N-\gamma}{r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{n}{r} \hat{u}_{in,M_{\tau}}^{\tau} & \frac{\delta}{\gamma_{\mathcal{F}}} \hat{u}_{in,M_{\tau}}^{\delta} & \cdots & \begin{pmatrix} N \\ \frac{N-\gamma}{r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N \\ \frac{N-\gamma}{r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{n}{r} \hat{u}_{in,M_{\tau}}^{N} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{n}{r} \hat{u}_{in,M_{\tau}}^{s} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r e^{j\varphi_{r_{\tau}}} \\ \vdots \\ r e^{j\varphi_{r_{N}}} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$
 (A)

	Û	$\frac{q}{2}\hat{u}^{r}$	$\frac{1}{2}\hat{u}^{\diamond}$		$\frac{1}{1}$)
	u _{in,} ,	۴ ⁽¹ <i>in</i> , ۱	۱۶ ^س in,۱		۲۵۶ "in,)	
	$\hat{u}_{in,r}$	$\frac{1}{r}\hat{u}_{in,r}^{r}$	$\frac{1}{18}\hat{u}_{in,\tau}^{a}$		$\frac{1}{100}\hat{u}_{in,r}^{ir}$	
	:	÷	:	·	÷	
	$\hat{u}_{in,M}$	$\frac{\mathbf{q}}{\mathbf{r}}\hat{u}_{in,M}^{\mathbf{r}}$	$\frac{1}{18}\hat{u}_{in,M}^{a}$		$\frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1} \hat{u}_{in,M}^{1r}$	
		$rac{r}{r}\hat{u}_{\scriptscriptstyle in, \imath}^{ m r}$	$\frac{\Delta \cdot}{\Sigma} \hat{u}_{in,\Sigma}^{a}$		$rac{\Delta\Delta\Upsilon\Pi\Upsilon\Psi}{\Pi^{\prime}}\hat{u}_{in,v}^{\prime m er}$	
		$\frac{r}{r}\hat{u}_{in,r}^{r}$	$\frac{\Delta}{\lambda \epsilon} \hat{u}_{in,\tau}^{\delta}$		$\frac{\Delta\Delta\Upsilon\Upsilon}{\Delta\Sigma\Upsilon}\hat{u}_{in,\tau}^{r}$	
(\hat{u})	:	:	:	·	:	
$\hat{u}_{out,G,Y}$ $\hat{u}_{out,G,Y}$		$\frac{r}{r}\hat{u}_{in,Mr}^{r}$	$\frac{\Delta}{\Sigma}\hat{u}_{in,M^{\gamma}}^{\scriptscriptstyle \Delta}$		$\frac{\Delta\Delta\Upsilon\Gamma\Upsilon}{\Gamma\Gamma\Upsilon}\hat{u}_{in,MT}^{\Gamma}$	
$\hat{u}_{out,G,M}$	•	•	$\frac{1}{18}\hat{u}_{in,v}^{a}$		$\frac{\mathfrak{r}\mathfrak{r}\mathfrak{s}\mathfrak{r}\mathfrak{r}}{\mathfrak{r}\mathfrak{r}\mathfrak{r}}\hat{u}_{in,n}^{\mathrm{r}\mathfrak{r}}$	
$\hat{u}_{out, r IMD, v}$		•	$\frac{1}{\hat{u}_{in}}$		$\frac{\mathfrak{r}\cdot\mathfrak{s}\mathfrak{r}\mathfrak{r}}{-}\hat{u}_{in}$	
$u_{out,rIMD,r}$:	:	۱۶ :	·	1.74	
$\hat{u}_{out, r IMD, M r}$ $\hat{u}_{out, r IMD}$		•	$\frac{1}{18}\hat{u}_{in,Mr}^{a}$		$\frac{\texttt{respire}}{\texttt{i}\mathfrak{r}\mathfrak{s}\mathfrak{s}\mathfrak{r}\mathfrak{s}}\hat{u}_{in,M\mathfrak{r}}^{\mathfrak{r}\mathfrak{r}}$	
$\hat{u}_{out, \delta IMD, \Upsilon}$			$rac{ra}{rr}\hat{u}_{in,v}^{ m v}$		$\frac{\mathfrak{SNRFV}}{\mathfrak{DNF}}\hat{u}_{in,i}^{ir}$	
$\hat{u}_{out, \Delta IMD, Mr}$		•	$\frac{\mathrm{va}}{\mathrm{cr}}\hat{u}_{\mathrm{in},\mathrm{v}}^{\mathrm{v}}$		$\frac{\mathcal{F}}{\mathcal{F}}$	$(- i\varphi_0)$
$\hat{u}_{out, \forall IMD, \vee}$:	÷	:	·	:	$\begin{bmatrix} c_1 e^{j\varphi_{c\tau}} \\ c_r e^{j\varphi_{c\tau}} \end{bmatrix}$
$u_{out, YIMD, Y}$		•	$\frac{ra}{r}\hat{u}_{in,M}^{r}$		$\frac{\mathcal{F}}{\partial \mathcal{V}} \hat{u}_{in,M^{\mathfrak{r}}}^{\mathfrak{r}}$	$c_{\Delta}e^{j\varphi_{c\Delta}}$
$\hat{u}_{out, \forall IMD, M *}$	-	•	$\frac{179}{100}\hat{u}_{in,1}^{9}$	$\frac{r_{\Delta F1}}{m_{in,1}} \hat{u}_{in,1}^{(1)}$	$\frac{1800}{1000}\hat{u}_{in,1}^{ir}$	$\begin{bmatrix} C_{\gamma} e^{j\varphi_{c\gamma}} \\ C_{\gamma} e^{j\varphi_{c\gamma}} \end{bmatrix}$
$\hat{u}_{out,\text{NIMD,N}}$ $\hat{u}_{out,\text{NIMD,N}}$		•	178 <u>178</u> <u>û</u> °	211 <u>Tari</u> û	$\frac{18000}{\hat{\mu}^{10}}$	$c_{11}e^{j\varphi_{c11}}$
	:	:	τας :	۵۱۲	۸ :	$(c_{ir}e^{irrer})$
$ u_{out, \forall IMD, M \diamond} $		•	۱۲۶ ۵۱	۲۵۴۱ ۵۱۱	۱۶۷۳۱ میں	
		•	<u>τ</u> αρ μ _{in,M δ}	$\Delta \eta \tau^{u_{in,M}}$	λ	
$ \underline{v}_r $	`	$\frac{r}{r}\hat{u}_{in,i}^{r}$	$\frac{1}{18}\hat{u}_{in,1}^{\dagger}$		$\frac{\mathbf{W}}{\mathbf{Y}}$ $\hat{u}_{in,v}$	
$ \underline{v}_{Ms} $	\ \	$rac{r}{r}\hat{u}_{\scriptscriptstyle in,r}^{\scriptscriptstyle au}$	$\frac{1}{18}\hat{u}_{in,r}^{*}$		$\frac{1115}{\mathbf{r}^{11}}\hat{u}_{in,r}^{1r}$	
$arphi_{r}$ $arphi_{r}$	١	$\frac{r}{s}\hat{u}_{in,r}^{r}$	$\frac{1}{16}\hat{u}_{in,r}^{\dagger}$		$\frac{1115}{1000}\hat{u}_{in,r}^{1r}$	
$arphi_r$;	:	·	۲ :	-
$\left(\varphi_{M}, \right)$	۱.	$\frac{r}{r}\hat{u}_{in,Ms}^{r}$	$\frac{1}{18}\hat{u}_{in,Ms}^{*}$		$\frac{1119}{\mathbf{x}^{11}}\hat{u}_{in,Ms}^{11}$	
	· \	$\frac{r}{r}\hat{u}_{in,v}$	$\frac{1}{12}\hat{u}_{in,1}^{\dagger}$		$\frac{1}{1}$	
	\ \	$\frac{r}{d}\hat{u}_{in,r}$	$\frac{1}{100}\hat{u}_{in,r}^{\dagger}$		$\frac{r}{\frac{1}{1}}$	
		٣	15		T IVIE au	
		$-u_{in,r}$	$\frac{u_{in,r}}{v}$		$\overline{\boldsymbol{\gamma}}^{\mathrm{rr}} u_{\mathrm{in},\mathrm{rr}}^{\mathrm{rr}}$	
	:	:	:	·	:	-
		$\frac{r}{r}\hat{u}_{in,Ms}^{r}$	$\frac{1}{18}\hat{u}_{in,Ms}^{*}$		$\frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{Y}}^{\mathbf{Y}}\hat{u}_{in,Ms}^{\mathbf{Y}}$	



شکل ۶: تقویت کننده توان استفاده شده در تست های عملی.



(ب)

شکل ۷: نحوه اندازه گیری های عملی مشخصه تابع تبدیل توان تقویت کننده ها، (الف) نحوه نصب و (ب) مدار اندازه گیری شده.

$$e_{Sum} = e_{y} + e_{y} + e_{y} + e_{z} + e_{z} + e_{z} = \sum_{i=1}^{n} g_{i} (|y_{ym}(\underline{C})| - y_{yi})^{y} + \dots + \sum_{i=1}^{n} g_{i} (|y_{zm}(\underline{C})| - y_{zi})^{y}$$
(1A)

لازم به ذکر است که در تابع خطای کل بهتر آن است از فاکتورهای وزنی (G_r, G_r) به ذکر است که در تابع خطای کل بهتر آن است از فاکتورهای وزنی (G_r , G_r , G_r) برای هر سیگنال خروجی استفاده شود تا این که بتوان سیگنال خروجی یا سیگنالهای خروجی را با تغییرات این وزنها بر حسب نیاز بهینه کرد. بنابراین (۱۸) در شکل جدید به صوت زیر نوشته می شود

$$\begin{aligned} e'_{Sum} &= G_{Y} \times e_{Y} + G_{Y} \times e_{Y} + G_{Y} \times e_{Y} + \\ G_{Y} \times e_{Y} + G_{a} \times e_{b} + G_{p} \times e_{p} \end{aligned}$$
(19)

بررسیها نشان میهد که همه ثابتهای مدل (ثابتهای سری) به دست آمده را نمیتوان با خطاهای کوچک تعیین کرد [۱۲] به ویژه انطباق سیگنالهای IMD درجات بالاتر در دامنههای بزرگتر مشکلتر است. به این دلیل در (۱۹) فاکتورهای وزنی مختلف طوری انتخاب شدهاند که سیگنالهای مهم یعنی سیگنالهای اصلی و TMD و قدر مطلق و



ک انالایزر تضمیف کننده توان تقویت کننده توان با (۱۰۰ W, -۳۰ dB)

شکل ۸: نحوه اندازه گیری های عملی مشخصه قدر مطلق و فاز بهره تقویت کننده ها، (الف) نحوه نصب و (ب) مدار اندازه گیری شده.

فاز بهره تقویت کننده بهتر از سیگنالهای دیگر به مقادیر اندازه گیری نزدیکتر شوند، به عبارت دیگر فاکتورهای وزنی G_{r} ، G_{r} ، G_{r} و G_{s} نسبت به وزنهای دیگر بزرگتر انتخاب شدهاند.

٤- مقایسه نتایج تئوری و عملی

در این قسمت ابتدا نحوه اندازه گیری عملی تقویت کنندهها توضیح داده شده و سپس مقایسهای بین مقادیر اندازه گیریها و مدل حاصل انجام خواهد گرفت. برای اندازه گیری های مشخصه توان، سیگنال های دو $f_r = 9$ ۱۱MHz منبع سینوسی با فرکانسهای $f_r = 9$ ۱۰MHz منبع سینوسی ا (فرکانسهای محدوده کار GSM) به وسیله تزویج کننده جهتدار dB+ (wilkinson) ترکیب و به تقویت کننده ا تزریق شده و سپس توان های خروجی در حوزه فرکانس به کمک اسپکتورم آنالایزر HP۸۵۶۵E رسم شدهاند (شکلهای ۲ و ۳). برای اندازه گیری بهره مختلط تقویت کنندهها در محدوده اشباع نیز دو سر ورودی و خروجی تقویت کننده به پورتهای نتورک آنالایزر HPAYTC متصل می شود. از آنجایی که توان ورودی قابل تحمل برای آنالایزر محدود است از یک تضعیف کننده در ورودی آن استفاده شده است (به مقادیر بهره در شکلهای ۲ و ۳ باید dB ۳۲ اضافه شود). تقویت کننده های استفاده شده در مدار، مدل MHW۹۱۶ (سیلسیسم، FET) هستند که از اتصال سری چندین تقویت کننده کوچکتر با توان خروجی کل حدود ۱۶ W و بهره کل حدود ۵۳ dB تشکیل شدهاند (شکل ۶). شکلهای ۷ و ۸ نحوه اندازه گیریهای عملی مشخصه توان و بهره تقویت کننده را نشان میدهند.



شکل ۹: مقایسه مدل و اندازه گیری های تابع تبدیل تقویت کننده *A*، (الف) سیگنال های اصلی و IMD درجات مختلف و (ب) قدر مطلق و فاز بهره ولتاژ.

در شکلهای ۹ و ۱۰ مقادیر اندازه گیری و مدل دو تقویت کننده برای مشخصه توابع تبدیل توان و بهره (قدر مطلق و فاز) مقایسه شدهاند (به علت کاهش خطا، از سیگنالهای ۹IMD در مدل نهایی صرف نظر شده است) و مقادیر عددی ثابتها در پیوست آمده است. در شکلهای ۹- ب و ۱۰-ب یک تطبیق خوب برای قدر مطلق و فاز بهره هر دو تقویت کننده مشاهده می شود. خطای به دست آمده برای فاز فقط در حدود چند درجه و برای قدر مطلق حدوداً dB ۰٫۵ است. همچنین مشاهده می شود منحنیهای سیگنالهای اصلی و ۳IMD در مشخصه توابع تبدیل توان از یک تطبیق بسیار خوب برخوردارند. برای سیگنالهای ۵IMD و ۷IMD با افزایش دامنه ورودی، عدم انطباق بین مقادیر اندازه گیریها و مدل با نوسان ملايم ظاهر مي شود (بايد توجه كرد كه براي تطبيق بهتر سیگنالهای اصلی و TIMD و مهمتر بودن این سیگنالها ثابتهای وزنی أنها بزرگتر انتخاب شدهاند). دقت مدل به دست أمده قبل از هر چیز به محدوده دامنه سیگنالهای ورودی بستگی دارد. هرچه به محدوده اشباع نزدیکتر می شویم دقت مدل کمتر می شود که دلیل اصلی آن به نقش ثابتهای با درجات بالاتر برمی گردد. پس از یک طرف با افزایش مؤلفههای درجات بالاتر در سری، مدل بیشتر به مقادیر اندازه گیری نزدیک می شود و از طرف دیگر خطای تقریب در نزدیک مرزهای محدوده تقریب، بیشتر و در منطقه فراتر از آن، مدل واگرا می شود. برای حصول

۳۸,۵ desired signal (measurement) ۲ desired signal -) dBi (model) "IMD (meas...) ™IMD (model) P_{out}/[dBm] ۵IMD (meas...) ۵IMD (model) vIMD (meas…) VIMD (model) -9 -A. _V. - ٣ - 7 . - à -1",A -1 P_{in}/[dBm] (الف) - V -۵٢ - 4 magnitude/[dB] phase/[deg] 21 -11 ۴۸ magnitude (measurement) ۴V magnitude (model) -17phase (measurement 19 phase (model) 172 -15. - ۴۵ -00 - 4. - 5. - 74 - 7 . - 50 -14 - 14 P_{in}[dBm]

شکل ۱۰: مقایسه مدل و اندازه *گیری*های تابع تبدیل تقویت کننده *B*، (الف) سیگنالهای اصلی و IMD درجات مختلف و (ب) قدر مطلق و فاز بهره ولتاژ.

بهترین مدل ممکن، مقادیر مختلف N امتحان شده است. با افزایش N مقادیر اندازه گیریها و مدل بیشتر به هم نزدیک می شوند اما برای مقادیر بزرگتر از ۱۳ مدل بهتر نمی شود. مدلهای دو تقویت کننده برای ورودیهای با دامنههای بزرگتر (محدوده کاملاً اشباع غیر خطی) نیز شرسی شده که نتایج به دست آمده رضایت بخش نبوده است [۱۲]. در شبیه سازی مدار مشخص شده که تعداد سیگنالهای خروجی تقویت کننده می بای سیکنال های خروجی تقویت کننده می اشیه سیگنالهای حدود A سیگنال های خروجی تقویت کننده برای می اسیه سازی مدار مشخص شده که تعداد سیگنالهای خروجی تقویت کننده می شوند. با این حجم زیاد سیگنال های مختلف) حدود A سیگنال مای تقویت کننده می امی می این حجم زیاد سیگنال های خروجی تقویت کننده می بندی می این حجم زیاد سیگنال مای محرو می مختلف مدان یا سیگنال مای موزه می می می می می می می منده که تعداد سیگنال مای محرو می منطقی است و به عبارت دیگر محاسبه سیگنال های خروجی تقویت کننده می خروجی تقویت کننده می می این در حوزه زمان یا در خروه فرکانس به علت طولانی بودن زمان محاسبات غیر عملی است. بدین جهت از روش گسسته عددی (به کمک ^۱ DFT) در MATLAB می شیدی است. برنامههای بای می بای می بای می بای مدان مده که نسبیه محرو زیاد می کنال های در حوزه زمان یا در نوزه فرکانی به کار بردن یک روش تحلیلی برای محروزه فرکانس به علت طولانی بودن زمان محاسبات غیر عملی است. بنی به می نیز دیگر همچون ¹ ADS و ⁷ AWR، محدودیتهایی برای مدل شده ای ندان دیگر همچون ¹ AW

^{1.} Discrete Fourier Transform

^{2.} Advance Design System

^{3.} Advancing the Wireless Revolution



شکل ۱۱: مقایسه منحنی Backoff (بر حسب توان ورودی) مدار جمع کننده جدید با مدار جمع کننده متداول در تحت فشار گذاشتن سیگنال ۳IMD.

برای اثبات کارکرد عملی مدار، یک نمونه آزمایشگاهی ساخته و اندازه گیری شده است. نتایج مدار جمع کننده جدید با مدار جمع کننده متداول (با دو تقویت کننده نوع *A* در حالت موازی) و در شرایط یکسان (یعنی توان ورودی یکسان) برای حالت گاهش ای ورودی کوچک برای کاهش سیگنالهای مزاحم- در اینجا MIMD) در شکل ۱۱ مقایسه شده است. همان طور که دیده می شود، مدار جمع کننده جدید در مقایسه با مدار جمع کننده متداول در یک گستره قابل توجهی (در محدوده اشباع) سیگنالهای MIMD را تحت فشار قرار می دهد و به عبارت دیگر مدار در این گستره خطی شده است.

اما حذف سیگنالهای TIMD به یک رنج محدودی از دامنه ورودی محدود شده و دامنه سیگنالهای TIMD در مقایسه با مدار جمع کننده متداول در خارج از این رنج بهتر نشده است. برای کاربردهای عملی این این امر دور از انتظار نیست چرا که مدار فقط برای همین دامنه ورودی محدود تنظیم شده است. این بدان معنی است که برای گستره بزرگ تغییرات دامنه ورودی (مقادیر دامنههای کوچک تا بزرگ) ، حلقههای تشکیل دهنده مدار نیز متناسباً باید تنظیم شوند. باید توجه کرد در مواردی که فقط تغییرات جزئی دامنه ورودی مد نظر است مثل تقویت کنندههای مورد استفاده در ماهوارههای تلویزیونی، خطی شدن (یعنی همان حذف سیگنالهای TIMD) به وسیله مدار جدید در مقایسه با مدار جمع کننده متداول به طور محسوسی بهبود یافته است.

در نمونه عملی آزمایش شده، بازدهی مدار حدود ۳۶٪ اندازه گیری شده است که حاکی از افزایش ۳ برابری در مقایسه با مدار فیدفوروارد متداول است. در انتها برای ارزیابی دقیق تر از نتایج به دست آمده، روش ارائه شده در این مقاله با روش های دیگر خطی سازی در جدول ۱ مقایسه شده است.

٥- نتيجه گيرى

مقاله ارائهشده تحقیقی برای ادغام مدارهای جمع کننده متداول و تقویت کننده فیدفوروارد متداول است چرا که ترکیب جمع توانهای دو تقویت کننده (در جمع کنندههای متداول) با حذف همزمان سیگنالهای MIMD در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برای توصیف ریاضی کل مدار، هر تقویت کننده توان بالا جداگانه تحلیل شد و به عبارت دیگر مدل ریاضی هر تقویت کننده تشکیل گردید. توصیف المانهای دیگر مدار به عنوان مدل ریاضی به سادگی انجام می گیرد چرا که رفتار آنها در محدوده تقطه کار مورد نظر کاملاً خطی است. برای تعیین مدل یک



شکل پ- ۱: مقایسه مدل و اندازه گیری های تابع تبدیل تقویت کننده ها برای سیگنال های اصلی و TIMD، (الف) تقویت کننده A و (ب) تقویت کننده B.

تقویت کننده توان بالا از اندازه گیری های سیگنال های اصلی و سیگنال های IMD درجات مختلف بر حسب توان ورودی و نیز از اندازه گیریهای بهره مختلط تقویت کننده در محدوده اشباع استفاده شده و اساساً ما می توانستیم هر کدام از اندازه گیری ها را با یک سری تیلور جداگانه توصیف کنیم که یک تقریب بسیار خوب نیز حاصل می شد. اما هیچ کدام از ثابتهای به دست آمده برای کل مدل تقویت کننده (یعنی همه منحنیها به طور همزمان) مناسب نمی بود. بدین جهت فقط از یک سری تیلور برای مدل کردن تقویت کننده استفاده شد که همه ثابتها به طور همزمان در همه منحنیها صدق کند. برای درست کردن مدلی واقعی تر که نمایانگر رفتار حقیقی تقویت کننده های توان بالا باشد، از ثابت های درجات بالاتر در سری استفاده شده است (اندازهگیریهای سیگنالهای IMD درجات بالا نیز مکمل تعیین دقیق تر ثابتهای سری است) اما با توجه به بزرگتر شدن مقادیر عددی ثابتها، خطای حاصل برای دامنههای بزرگتر بیشتر می شود. مناسب تر است برای پایداری بیشتر در مقابل تغییرات دما و مقابله با کهنگی ازمدارهای مجتمع برای دو تقویت کننده، بطور جداگانه استفاده شود. در کارهای عملی، تغییرات دامنه ورودی و نيز تغييرات شكل سيگنال و تغييرات دما در مدار بايد كنترل شود. اين کار با استفاده از تضعیف کننده متغیر و تغییردهنده فاز کنترل شده با میکروپروسسورها و سنسورهای حساس در ورودی تقویت کنندهها انجام می گیرد همان گونه که از مدار فیدفوروارد متداول می شناسیم.

پيوست

الف) در شکل پ- ۱ مدلهای دو تقویت کننده بر اساس سری تیلور (با

جدول ۱: مقایسه روشهای خطیسازی با همدیگر.

پهنای باند	پايدارى	بازدهی	خطیسازی	
محدود	محدودیت در فرکانسهای بالا	پايين	محدودیت کاهش سیگنالهای ۳IMD (محدودیت خطیسازی)	روش فیدبک (Feedback)
مناسب	پایداری بدون پیششرط	نسبتاً بالا	محدودیت کاهش سیگنالهای ۳IMD (محدودیت خطیسازی)	روش پرىديزتورشن (Predistortion)
مناسب	پایداری بدون پیششرط	پايين	مناسب (برای دامنههای کوچک)	روش فيدفوروارد (Feedforward)
مناسب	پايدارى بدون پيششرط	بالا	مناسب (برای دامنههای بزرگ)	روش ارائهشده فيدفوروارد جمع كننده (Feedforward Power Combiner)

- [2] K. Solbach, *Feed Forward Amplifier for GSM*, University Duisburg-Essen, Germany, Sep. 2002.
- [3] H. S. Black, Wave Translation System, USA Patent, US2,102,671, Dec. 1937.
- [4] N. Pothecary, *Feedforward Linear Power Amplifier*, Artech House, 1999.
- [5] P. B. Kenington, *High-Linearity RF Amplifier Design*, Artech House, 2000.
- [6] J. Eisenberg, L. Altos, and S. Avis, *Closed Loop Active Cancellation Technique (ACT)-Based RF Power Architecture*, USA Patent, US 6,452,446 B1, Sep. 2002.
- [7] K. J. Cho, J. H. Kim, and S. P. Stapleton, "RF high power doherty amplifier for improving the efficiency of a feed forward linear amplifier," *IEEE MTT-S Int. Microwave Symposium Digest*, vol. 2, pp. 847-850, Seoul, South Korea, Jul. 2004.
- [8] T. Ogawa, T. Iwasaki, H. Maruyama, K. Horiguchi, M. Nakayama, Y. Ikeda, and H. Kurebayash, "High efficiency feed-forward amplifier using RF predistortion linearizer and the modified doherty amplifier," *IEEE MTT-S Int. Microwave Symposium Digest*, vol. 2, pp. 537-540, Tokyo, Japan, 6-11 Jun. 2004.
- [9] E. Chong, *The Volterra Series and the Direct. Method of Distortion Analysis*, University of Toronto, Research Work, 2001.
- [10] J. Vuolevi and T. Rahkonen, *Distortion in RF Power Amplifier*, Artech House, 2003.
- [11] J. Aikio, Frequency Domain Model Fitting and Volterra Analysis Implemented on top of Harmonic Balance Simulation, Faculty of Technology, Department of Electrical and Information Engineering, University of Oulo, Research Work, 2007.
- [12] M. R. Motavalli, Untersuchung einer Leistungskombinations-Schaltung mit Feed Forward-Linearisierung, Dissertation, University Duisburg-Essen, Germany, Sep. 2010.
- [13] N. Carvalho and J. C. Pedro, "A comprehensive explantion of distortion sideband asymmetries," *IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques*, vol. 50, no. 9, pp. 2090-2101, Sep. 2002.
 [14] G. Xiangqian, K. Hongwen, and C. Hongxing, *The Least-Square*
- [14] G. Xiangqian, K. Hongwen, and C. Hongxing, *The Least-Square Method in Complex Number Domain*, Beijing, China, Mar. 2006.

محمدرضا متولى در سال ۱۳۶۹ مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه تبریز و کارشناسی ارشد و دکتری را در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ به ترتیب در رشتههای مهندسی الکترونیک و مهندسی الکترونیک فرکانسهای بالا از دانشگاههای بوخوم و دیسبورگ آلمان دریافت نمود. نامبرده در حین تحصیل در آلمان با برخی از شرکتهای آلمانی در انجام برخی پروژههای مرتبط با رشته برق نیز همکاری می کرده است. از سال ۱۳۹۰ ایشان عضو هیأت علمی گروه مخابرات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم می باشد. زمینههای تحقیقاتی مورد علاقه ایشان عبارتند از: طراحی مدارهای الکترونیکی به کمک تقویت کنندههای عملیاتی، تقویت کنندههای توان بالای RF، خطی کردن تقویت کنندههای توان بالا و کاربرد آنها در سیستمهای مایکروویو و ماهواره.

کلاوس سولباخ از سال ۱۹۹۵ میلادی دارای کرسی پروفسوری در رشته مهندسی الکترونیک فرکانسهای بالا در دانشگاه دیسبورگ آلمان میباشد. نامبرده کارهای تحقیقاتی بسیاری در مجلات معتبر از جمله در IEEE منتشر نموده است. انتشار بیش از ۱۰۰ مقاله از وی، او را از صاحبنظران ممتاز در کشور آلمان کرده است. زمینههای تحقیقاتی و تخصصی ایشان عبارتند از: طراحی آنتن و مدارهای مایکروویو، مخابرات بی سیم و مهندسی پزشکی. جدول پ– ۱: تقویت کننده A.

<u>C</u> ,	$-1/1770771.944.907\times1.5^{\circ}-j4/70.7010.57711\times1.5^{\circ}[-]$
\underline{C}_{r}	$-\mathbf{f}_{j}\mathbf{T}\mathbf{F}\mathbf{I}\mathbf{F}\mathbf{A}\mathbf{I}\mathbf{F}\mathbf{F}\mathbf{A}\mathbf{T}\mathbf{F}\mathbf{F}\mathbf{A}\mathbf{T}\mathbf{F}\mathbf{A}\mathbf{T}\mathbf{F}\mathbf{A}\mathbf{T}\mathbf{F}\mathbf{A}\mathbf{T}\mathbf{F}\mathbf{F}\mathbf{A}\mathbf{T}\mathbf{F}\mathbf{F}\mathbf{A}\mathbf{T}\mathbf{F}\mathbf{F}\mathbf{F}\mathbf{F}\mathbf{F}\mathbf{F}\mathbf{F}\mathbf{F}\mathbf{F}F$
\underline{C}_{\flat}	$1/r$ 9 λ ff+ff1VT+199×1+"- j 1/st9s1+t19 λ ffddt×1+" $[\frac{1}{V^{ au}}]$
$\underline{C}_{\mathbf{v}}$	-1/2 algo in the second in the second interval the second seco
<u>C</u> ,	\mathbf{N}_{j} tyndtmananananananananananananananananananan
<u>C</u> ,,,	$- \frac{\gamma}{5} \delta Y 1 \frac{1}{4} \frac{1}{V^{(1)}} + j \frac{1}$
$\underline{C}_{\rm vr}$	$\mathbf{f}_{j} \cdot 1 \cdot \mathbf{TS} \Delta \mathbf{Y} 1 \cdot \mathbf{TFF} 1 \Delta \mathbf{T} \times 1 \cdot \mathbf{T} + j 1_{j} \mathbf{TTF} 1 1 \Delta \Delta \mathbf{VFSTT} 1 \mathbf{T} \times 1 \cdot \mathbf{T} [\frac{1}{V^{\mathrm{tr}}}]$

جدول پ- ۲: تقویت کننده *B*.

<u>C</u> ,	a_j AATSS+SAYYS1QTQ×1+' - j^{a_j} S+TAT+TYTSTST1T×1+"[-]
\underline{C}_r	$-\Delta_j$ ٩١٤٩٧٧٩٩••۶٢٩Δ٧×١•* $-j\Delta_j$ ٣٩٢•٧٢••۶•١۶٩• Λ ×١•* $[\frac{1}{V^{\tau}}]$
\underline{C}_{\flat}	$1/97T187YAT1\Delta611\Delta\times10^{\circ} + j1/7T18681Y1111Y6T\Delta\times10^{\circ}[\frac{1}{U^{\dagger}}]$
<u>C</u> _v	$-\mathbf{v}_{j}$)) \mathbf{v}_{j}))) \mathbf{v}_{j})))
<u>C</u> ,	γ_j rdstaqvs•qratvf×1•' + jf_a1•qrttrfsfqrdv×1•'[$\frac{1}{V^*}$]
<u>C</u> ,,,	$-Y_{i} \texttt{TA} \cdot \texttt{YYV} \texttt{X} \texttt{T} \texttt{IS} \texttt{A} \texttt{TT} \texttt{A} \times \texttt{I} \cdot \texttt{T} - j \texttt{I}_{i} \texttt{Y} \texttt{T} \texttt{T} \texttt{A} \texttt{I} \texttt{A} \texttt{S} \texttt{F} \texttt{S} \texttt{I} \times \texttt{I} \cdot \texttt{T} \begin{bmatrix} 1 \\ V_{i} \end{bmatrix}$
\underline{C}_{uv}	$\lambda_{j}\lambda_{1}\gamma^{*}\gamma^{*}\gamma^{*}\gamma^{*}\gamma^{*}\gamma^{*}\gamma^{*}\gamma^{*$

ثابتهای حقیقی) نشان داده شدهاند که دور از رفتار حقیقی تقویت کنندهها است. همان گونه که ملاحظه می شود انحراف زیادی بین نتایج مدل و اندازه گیریها در محدوده دامنههای بزرگ برای سیگنالهای TIMD مشهود است و از آنجایی که این محدوده برای مدل یک تقویت کننده توان بالا مهم است، مدل حاصل پذیرفتنی نیست. ملزم بودن پارامترهای سری تیلور به دو فاز ثابت °۰ و ۲۰۸ دلیل اصلی این انحراف است و به عبارت دیگر سری تیلور با ثابتهای حقیقی فقط می تواند یک تبدیل AM/AM و نه تبدیل AM/PM را توصیف کند. با سری تیلور حقیقی، گردش یا تغییر فازها در مدل امکان ندارد.

P و B و A و P ثابتهای سری تیلور محاسبه شده برای دو تقویت کننده A و A به ترتیب در جداول y - 1 و y - 7 آمده اند.

مراجع

[1] S. Z. ASIF, *Wireless Communications Evolution to 3G and Beyond*, Artech House, 2007.